

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

保守/廃止

移動体通信用 低消費電流シリコン高周波増幅器MMIC

μ PC8179TBは移動体通信用各種パッファ・アンプとして開発したシリコン・モノリシックICです。本ICは出力端子にインダクタを外付けすることで従来の内部50 Ω 広帯域マッチングでは得られなかった低消費電流を実現します。電源電圧3.0 Vで動作するためシステムの低消費電力化に最適です。

本製品は、 $f_{max} = 30$ GHzの当社独自のシリコン・バイポーラ・プロセス「UHS0」（Ultra High Speed Process）により生産しています。本プロセスはダイレクト・シリコン窒化膜や金電極構造を採用しています。この構造はチップの耐湿性、耐食性に優れ、良好な電流特性、高周波特性を有しています。これにより電氣的特性、信頼性に優れた高品質のICとなっています。

特 徴

低消費電流	: $I_{CC} = 4.0$ mA TYP. @ $V_{CC} = 3.0$ V
電源電圧	: $V_{CC} = 2.4 \sim 3.3$ V
高効率	: $P_{O(1\text{ dB})} = +3.0$ dBm TYP. @ $f = 1.0$ GHz $P_{O(1\text{ dB})} = +1.5$ dBm TYP. @ $f = 1.9$ GHz $P_{O(1\text{ dB})} = +1.0$ dBm TYP. @ $f = 2.4$ GHz
電力利得	: $G_P = 13.5$ dB TYP. @ $f = 1.0$ GHz $G_P = 15.5$ dB TYP. @ $f = 1.9$ GHz $G_P = 15.5$ dB TYP. @ $f = 2.4$ GHz
高アイソレーション	: $ISL = 44$ dB TYP. @ $f = 1.0$ GHz $ISL = 42$ dB TYP. @ $f = 1.9$ GHz $ISL = 41$ dB TYP. @ $f = 2.4$ GHz
動作周波数	: 100 ~ 2 400 MHz帯に対応（外付けLC値調整）
高密度・面実装が可能	: 6ピン小型ミニモールド・パッケージ（ $2.0 \times 1.25 \times 0.9$ mm）
軽量	: 7 mg（標準値）

用途例

100 ~ 2 400 MHz帯移動体通信用システムの各種パッファ

オーダ情報

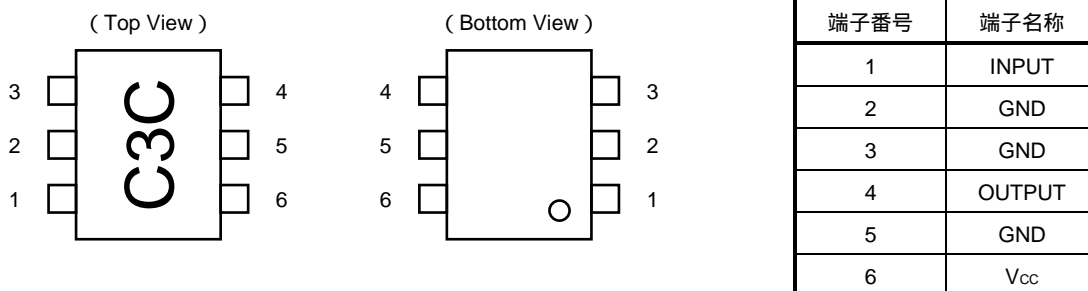
オーダ名称	パッケージ	捺印	包装形態
μ PC8179TB-E3	6ピン小型ミニモールド	C3C	・ 8 mm幅エンボス式テーピング。 ・ 1, 2, 3ピン側が送り丸穴。 ・ 3 k個 / リール。

備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください（名称： μ PC8179TB）。

本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

端子接続図

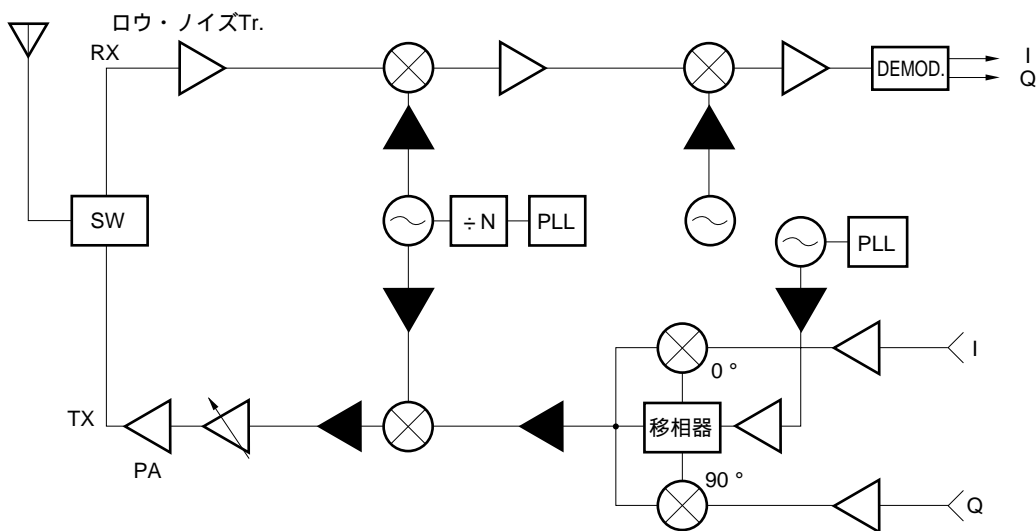


製品系列一覧 (T_A = +25 , V_{CC} = V_{out} = 3.0 V, Z_s = Z_L = 50 Ω)

項目 品名	I _{CC} (mA)	1.0 GHz出力マッチング時			1.66 GHz出力マッチング時			1.9 GHz出力マッチング時			2.4 GHz出力マッチング時			捺印
		G _P (dB)	ISL (dB)	P _{O(1 dB)} (dBm)	G _P (dB)	ISL (dB)	P _{O(1 dB)} (dBm)	G _P (dB)	ISL (dB)	P _{O(1 dB)} (dBm)	G _P (dB)	ISL (dB)	P _{O(1 dB)} (dBm)	
μPC8128TB	2.8	12.5	39	- 4.0	13	39	- 4.0	13	37	- 4.0	-	-	-	C2P
μPC8151TB	4.2	12.5	38	+ 2.5	15	36	+ 1.5	15	34	+ 0.5	-	-	-	C2U
μPC8152TB	5.6	23	40	- 4.5	19.5	38	- 8.5	17.5	35	- 8.5	-	-	-	C2V
μPC8178TB	1.9	11	39	- 4.0	-	-	-	11.5	40	- 7.0	11.5	38	- 7.5	C3B
μPC8179TB	4.0	13.5	44	+ 3.0	-	-	-	15.5	42	+ 1.5	15.5	41	+ 1.0	C3C

システム応用例

デジタル・セルラの例



部の周りで、アイソレーションやレベルが足りないときなどに使用することができます。

なお、この応用は一例ですので、ユーザが所望のブロックに必要な特性を引き出すことによりお使いいただけます。

端子機能説明

端子番号	端子名称	印加電圧 (V)	端子電圧 (V) 注	機能説明および使用法	内部等価回路
1	INPUT	-	1.09	入力端子です。 カップリング・コンデンサによりDCカットするとともに、信号源側のインピーダンス50Ωで入力が可能です。	
2	GND	0	-	グランド端子です。 グランド・パターンに接続してください。 グランド・パターンは最小インピーダンスとなるよう十分広くとってください。	
3					
5					
4	OUTPUT	インダクタでV _{CC} と同一電圧	-	出力端子です。ハイ・インピーダンス出力です。 外付けのL, Cで接続回路とのマッチングをとってください。特にLには高周波用の積層チップ・インダクタが使用できます。	
6	V _{CC}	2.4 ~ 3.3	-	電源電圧端子です。 バイパス・コンデンサを接続し、高周波インピーダンスを小さくしてください。	

注 端子電圧は、V_{CC} = 3.0 V時の値。

絶対最大定格

項目	略号	条件	定格	単位
電源電圧	V _{CC}	T _A = +25, 4ピン, 6ピン	3.6	V
回路電流	I _{CC}	T _A = +25	30	mA
★ パッケージ許容損失	P _D	50 × 50 × 1.6 mm両面銅箔ガラス・エポキシ 基板実装時, T _A = +85	270	mW
動作周囲温度	T _A		-40 ~ +85	
保存温度	T _{stg}		-55 ~ +150	
入力電力	P _{in}	T _A = +25	+5	dBm

推奨動作範囲

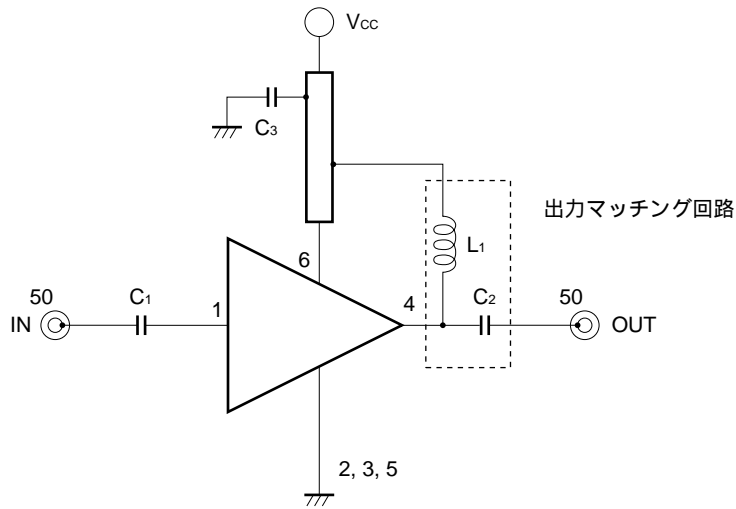
項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位	備考
電源電圧	V _{CC}	2.4	3.0	3.3	V	4ピン, 6ピンは同一電圧を印加のこと

電気的特性 (特に指定のないかぎり, T_A = +25, V_{CC} = V_{out} = 3.0 V, Z_s = Z_L = 50 Ω,
出力外付けマッチング周波数による)

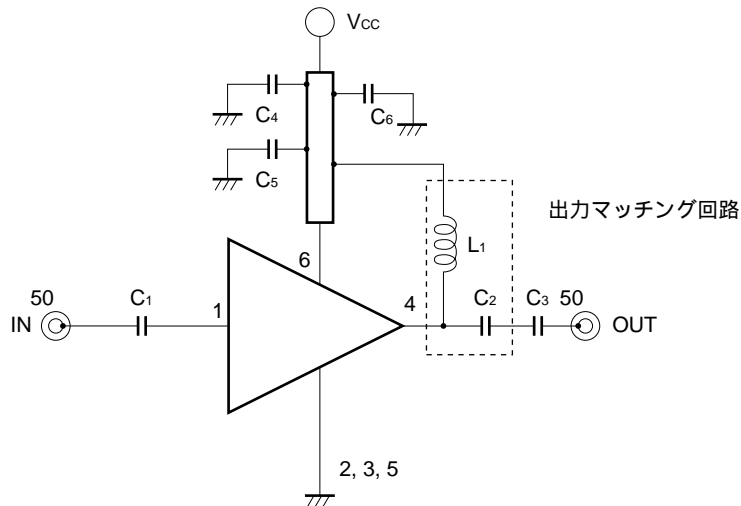
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
回路電流	I _{CC}	無信号時	2.9	4.0	5.4	mA
電力利得	G _P	f = 1.0 GHz, P _{in} = -30 dBm f = 1.9 GHz, P _{in} = -30 dBm f = 2.4 GHz, P _{in} = -30 dBm	11.0 13.0 13.0	13.5 15.5 15.5	15.5 17.5 17.5	dB
アイソレーション	ISL	f = 1.0 GHz, P _{in} = -30 dBm f = 1.9 GHz, P _{in} = -30 dBm f = 2.4 GHz, P _{in} = -30 dBm	39 37 36	44 42 41	- - -	dB
1 dB利得圧縮時出力電力	P _{O(1dB)}	f = 1.0 GHz f = 1.9 GHz f = 2.4 GHz	-0.5 -2.0 -3.0	+3.0 +1.5 +1.0	- - -	dBm
雑音指数	NF	f = 1.0 GHz f = 1.9 GHz f = 2.4 GHz	- - -	5.0 5.0 5.0	6.5 6.5 6.5	dB
入力側リターン・ロス	RL _{in}	f = 1.0 GHz, P _{in} = -30 dBm f = 1.9 GHz, P _{in} = -30 dBm f = 2.4 GHz, P _{in} = -30 dBm	4 4 6	7 7 9	- - -	dB

測定回路図

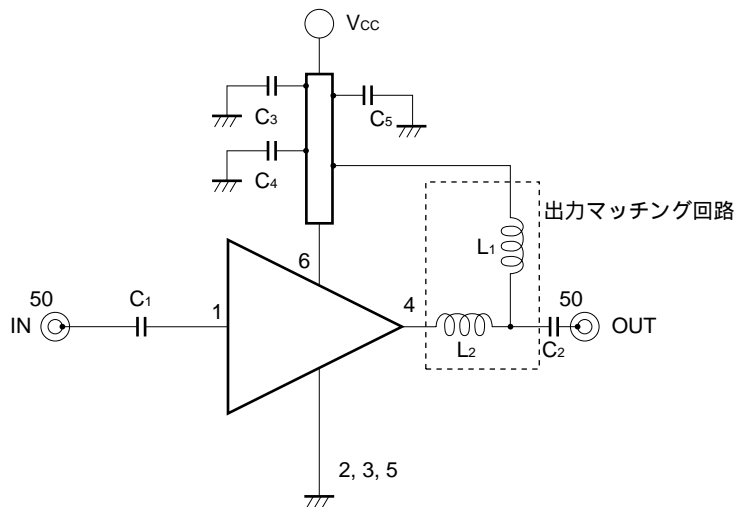
f = 1.0 GHz



f = 1.9 GHz

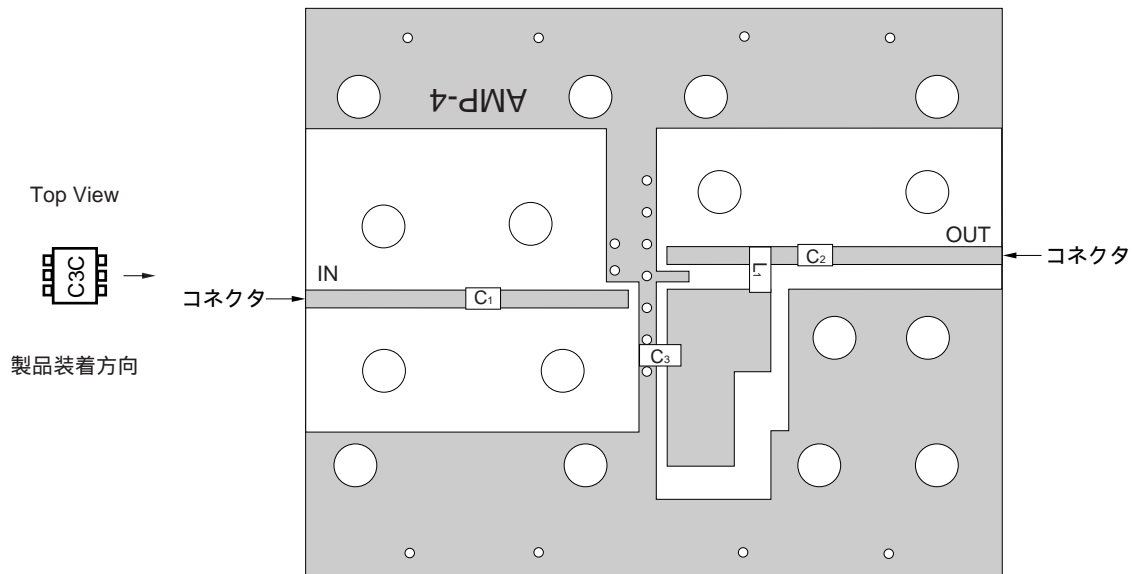


f = 2.4 GHz



測定回路のプリント基板例

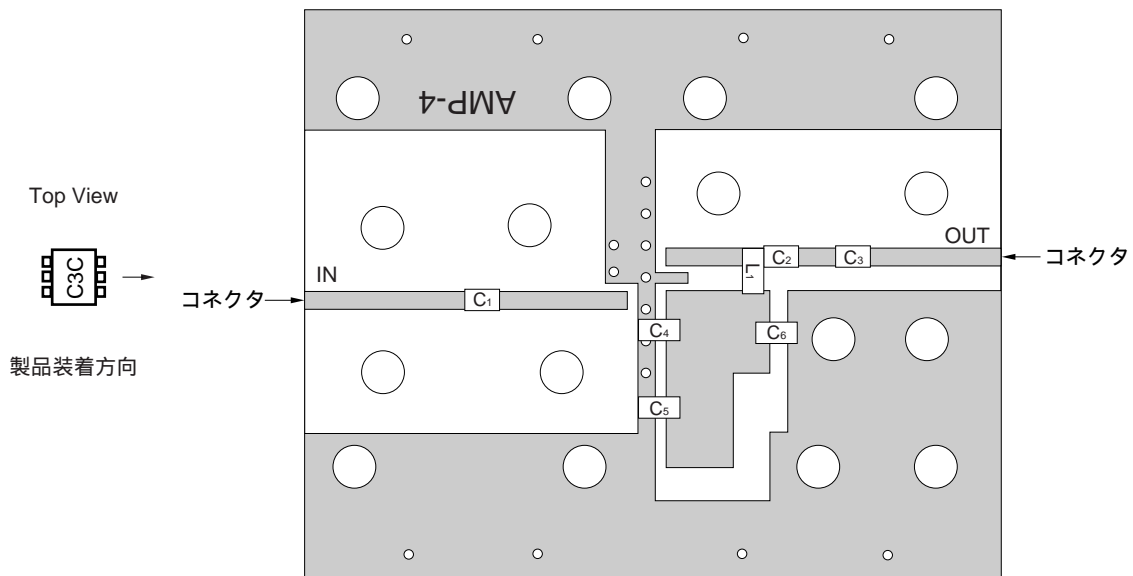
f = 1.0 GHz



部品表

	1.0 GHz出力マッチング時
C ₁	1 000 pF
C ₂	0.75 pF
C ₃	10 pF
L ₁	12 nH

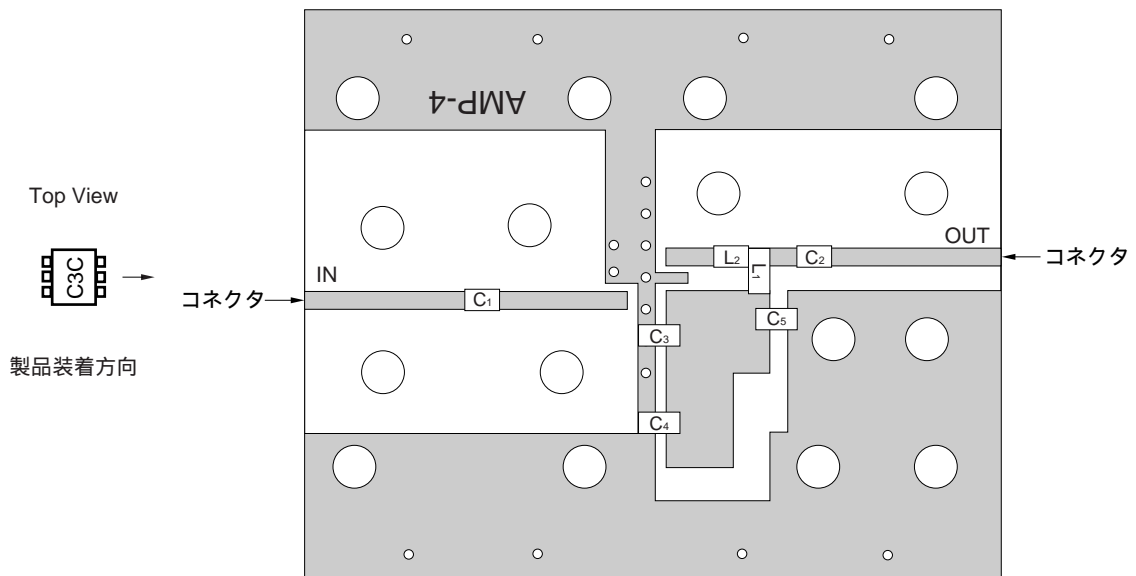
f = 1.9 GHz



部品表

	1.9 GHz出力マッチング時
C ₁ , C ₃ , C ₅ , C ₆	1 000 pF
C ₂	0.75 pF
C ₄	10 pF
L ₁	3.3 nH

f = 2.4 GHz



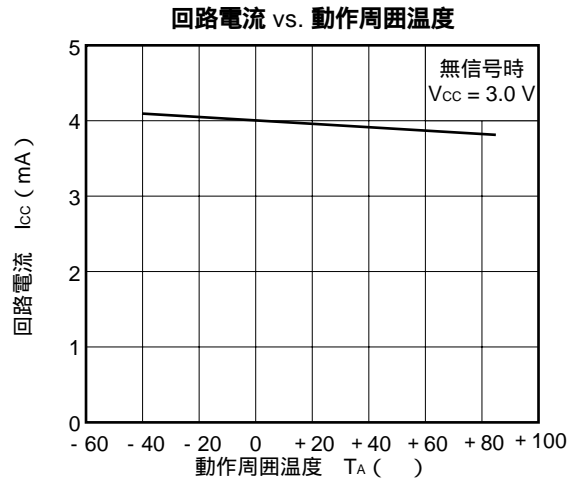
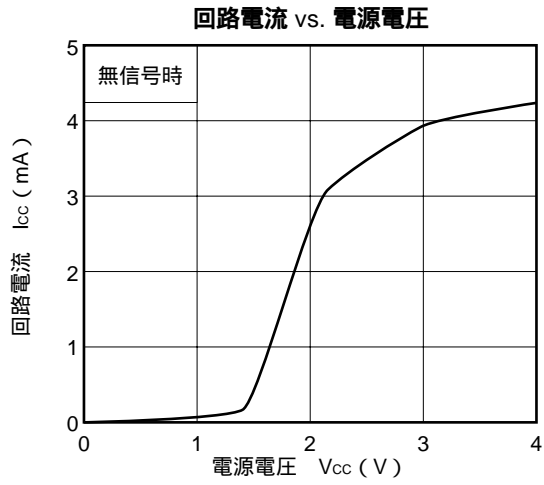
部品表

	2.4 GHz出力マッチング時
C ₁ , C ₂ , C ₄ , C ₅	1 000 pF
C ₃	10 pF
L ₁	1.8 nH
L ₂	2.7 nH

基板例注釈

- (* 1) 42 × 35 × 0.4 mmポリイミド板に両面18 μm厚銅パターンニング
- (* 2) 裏面グラウンド・パターン
- (* 3) パターンニング面は半田メッキ
- (* 4) はスルー・ホール

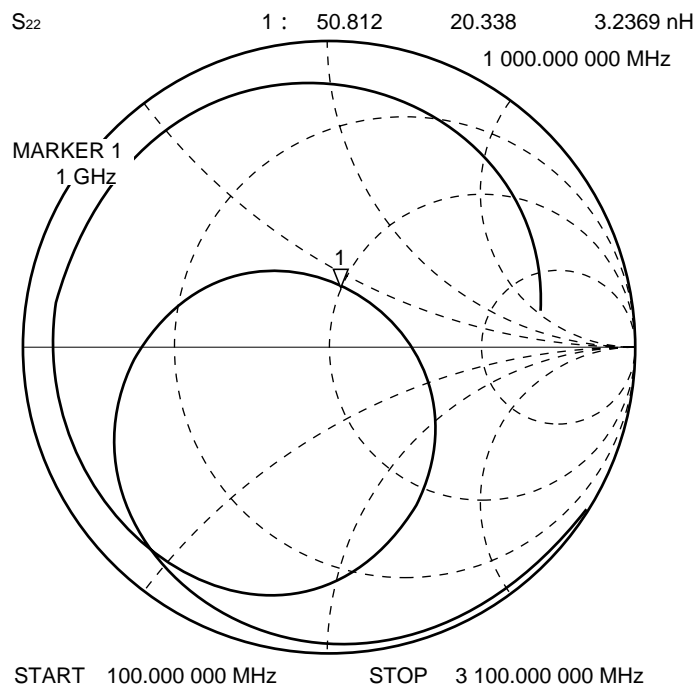
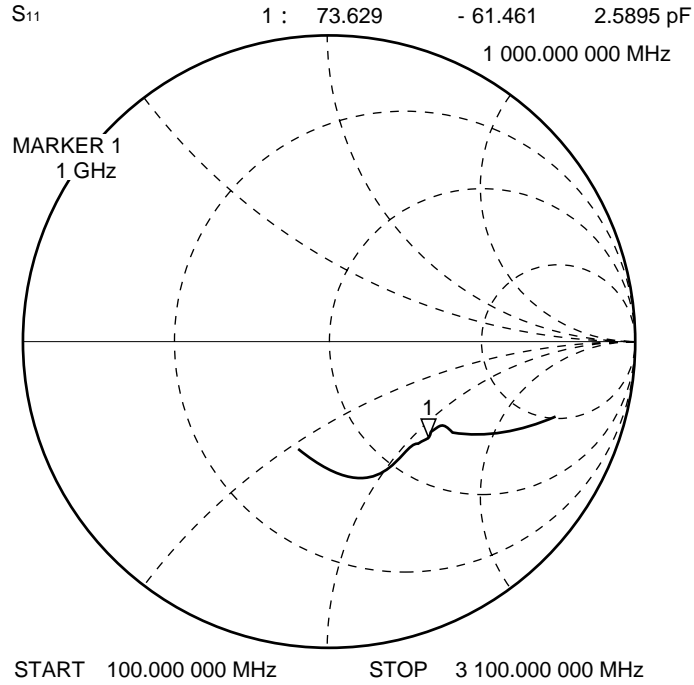
特性曲線 (特に指定のないかぎり, $T_A = +25$)



出力1.0 GHzマッチング時

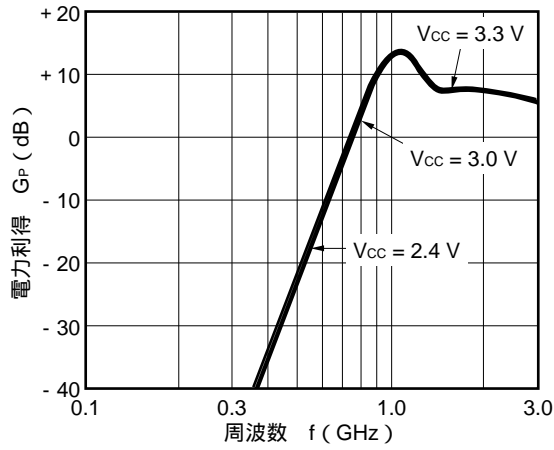
Sパラメータ (測定治具のコネクタ部にてモニタ)

$T_A = +25$, $V_{CC} = V_{out} = 3.0$ V

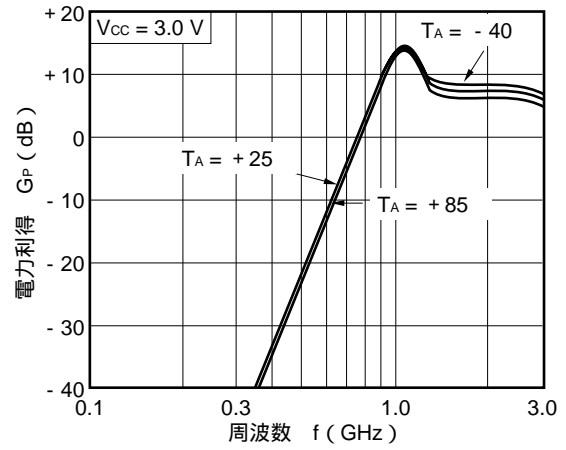


出力1.0 GHzマッチング時

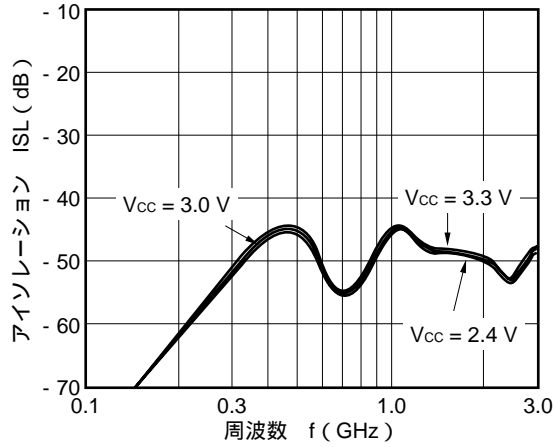
電力利得 vs. 周波数



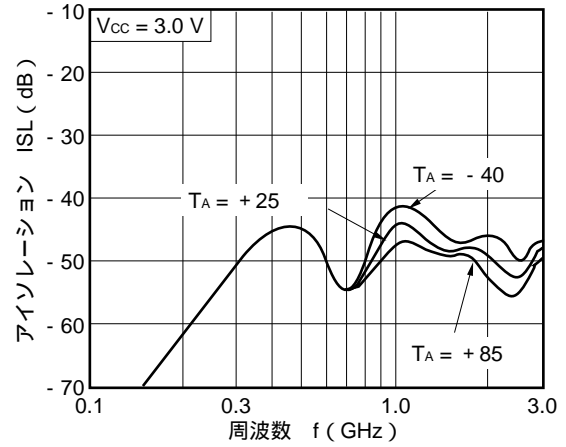
電力利得 vs. 周波数



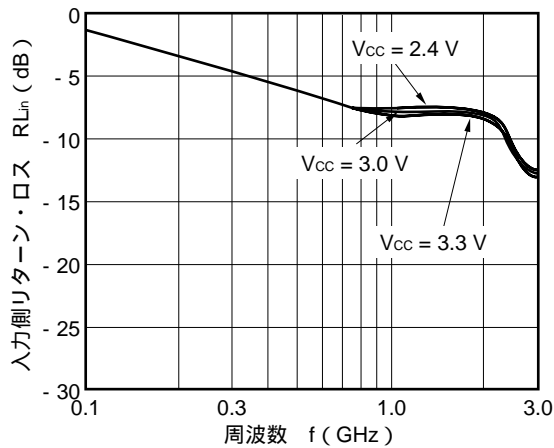
アイソレーション vs. 周波数



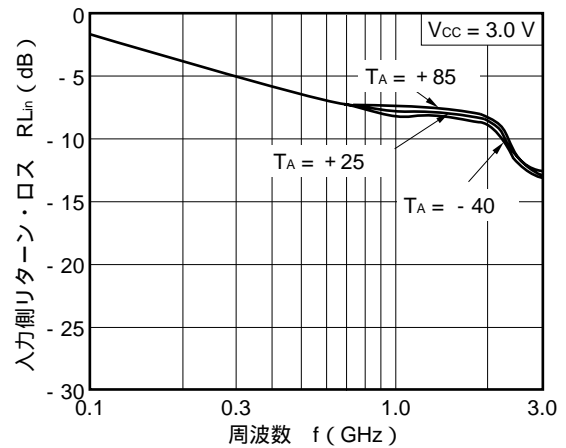
アイソレーション vs. 周波数



入力側リターン・ロス vs. 周波数

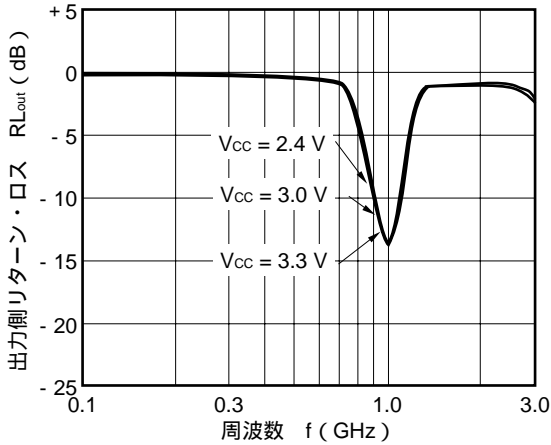


入力側リターン・ロス vs. 周波数

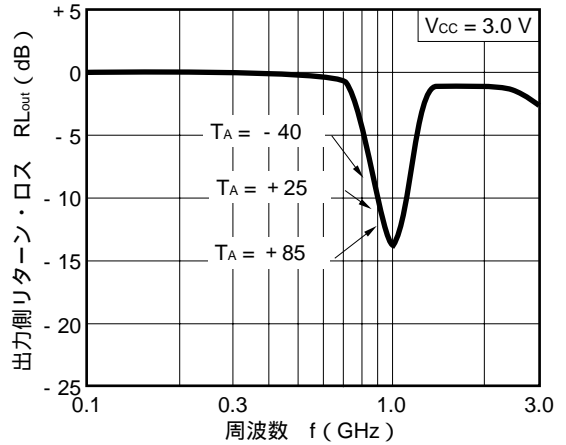


出力1.0 GHzマッチング時

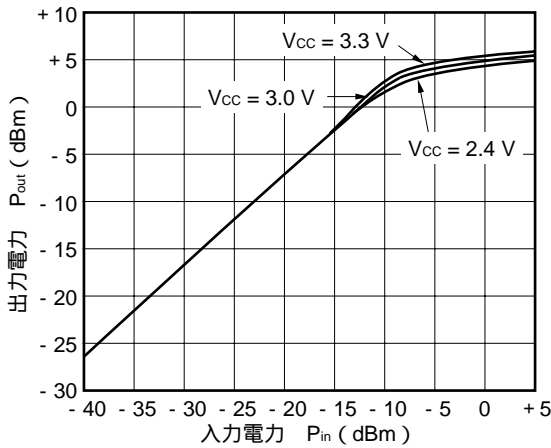
出力側リターン・ロス vs. 周波数



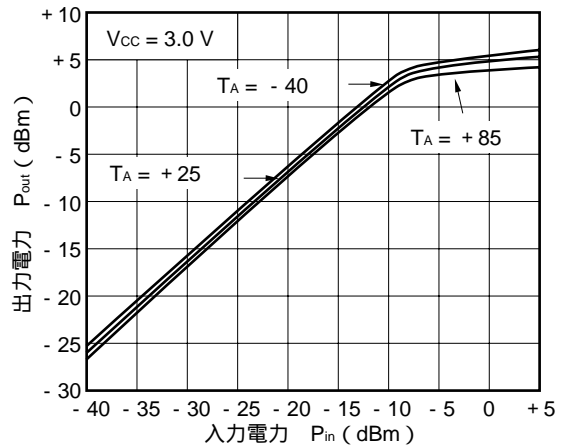
出力側リターン・ロス vs. 周波数



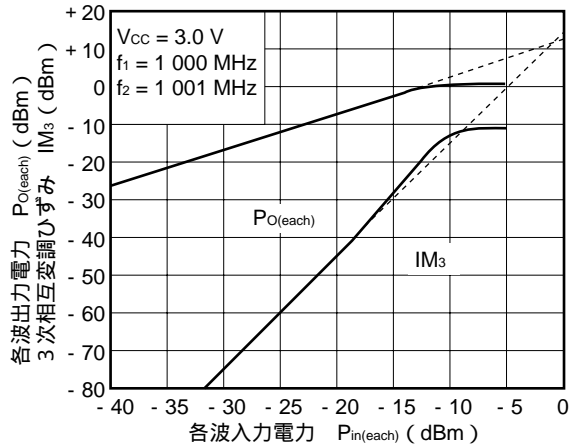
出力電力 vs. 入力電力



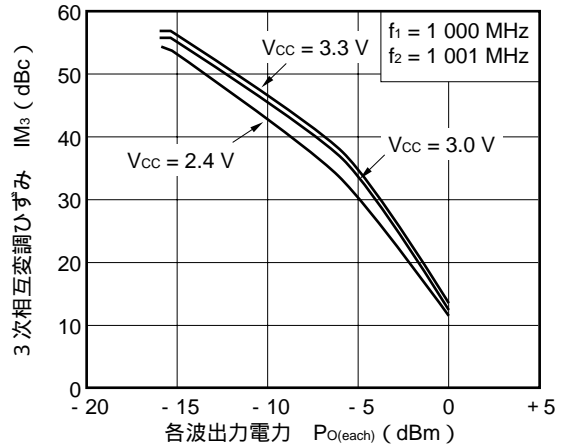
出力電力 vs. 入力電力



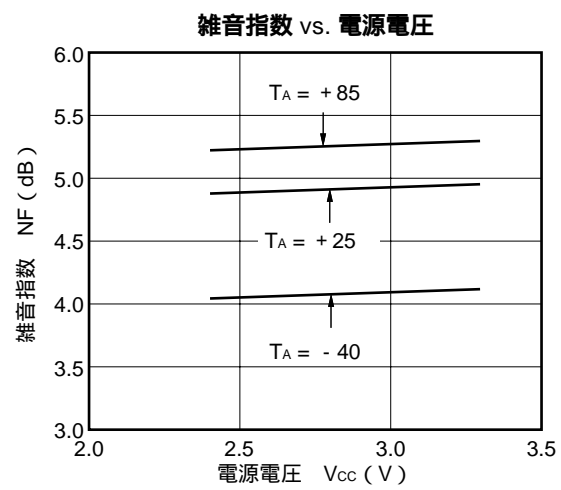
各波出力電力, 3次相互変調ひずみ vs. 各波入力電力



3次相互変調ひずみ vs. 各波出力電力



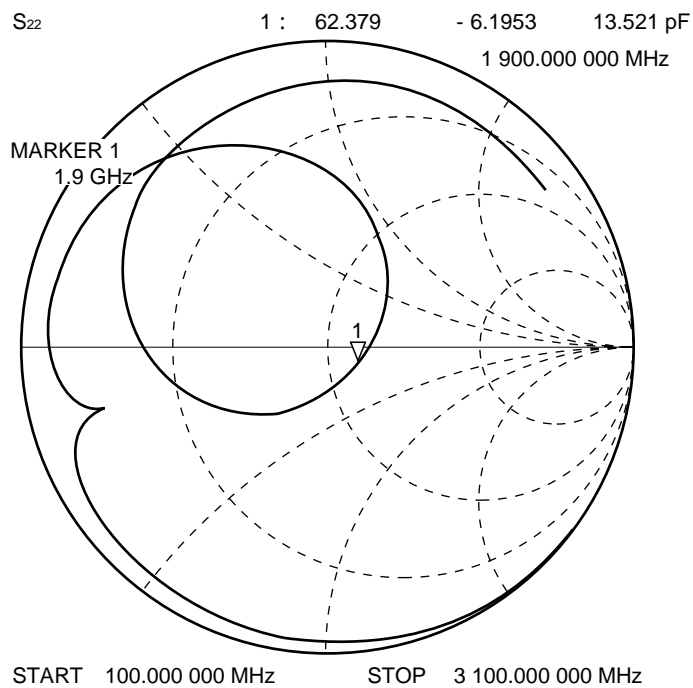
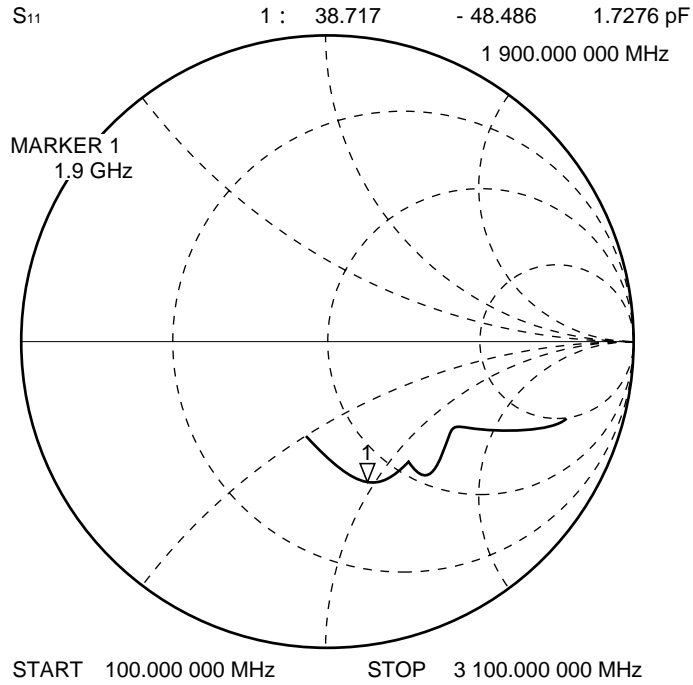
出力1.0 GHzマッチング時



出力1.9 GHzマッチング時

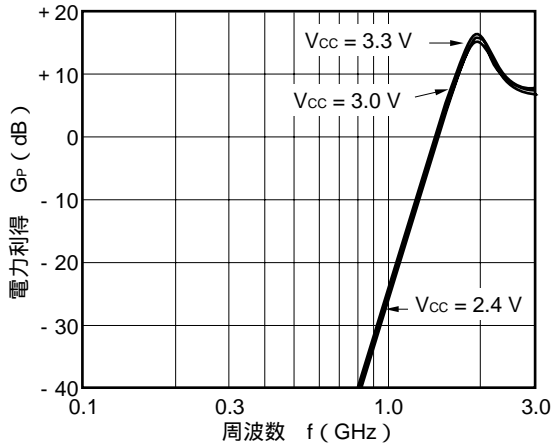
Sパラメータ (測定治具のコネクタ部にてモニタ)

$T_A = +25$, $V_{CC} = V_{out} = 3.0$ V

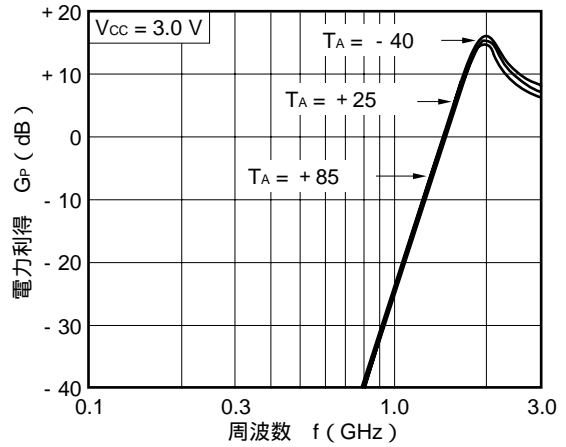


出力1.9 GHzマッチング時

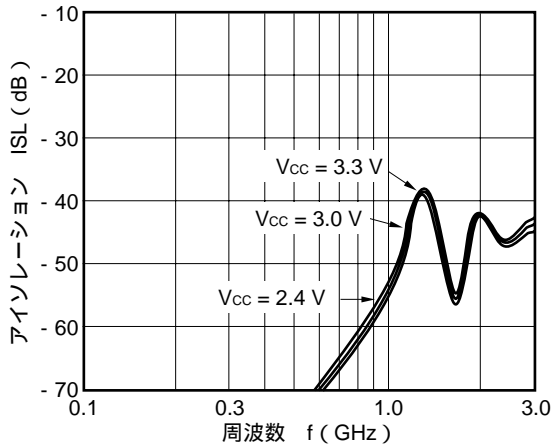
電力利得 vs. 周波数



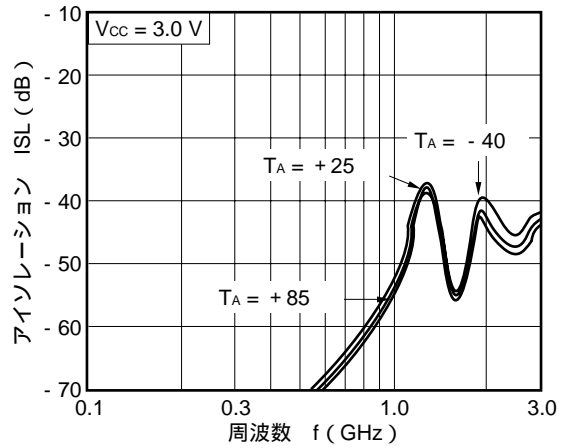
電力利得 vs. 周波数



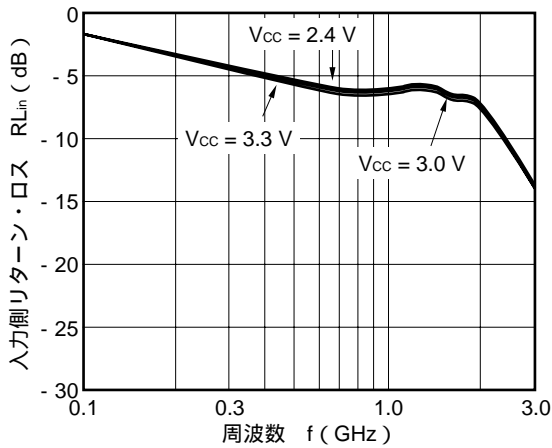
アイソレーション vs. 周波数



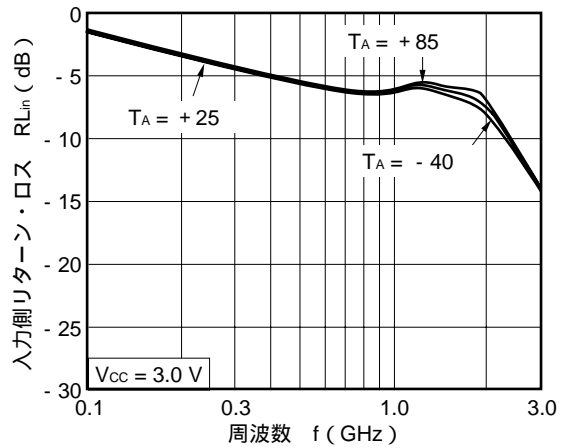
アイソレーション vs. 周波数



入力側リターン・ロス vs. 周波数

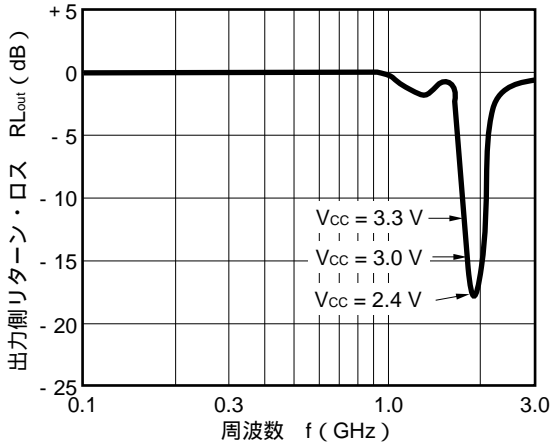


入力側リターン・ロス vs. 周波数

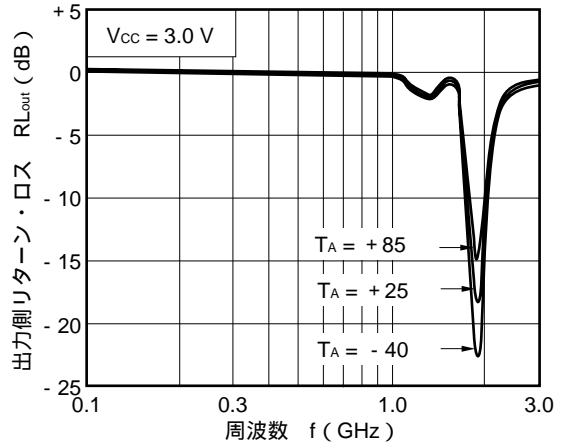


出力1.9 GHzマッチング時

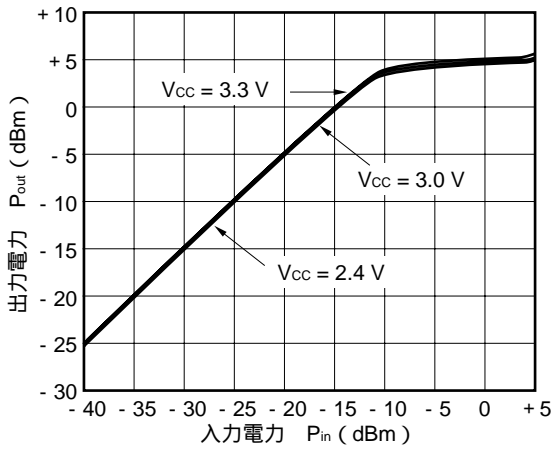
出力側リターン・ロス vs. 周波数



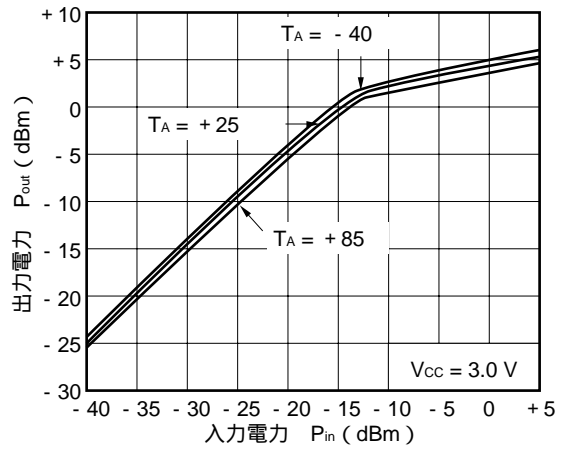
出力側リターン・ロス vs. 周波数



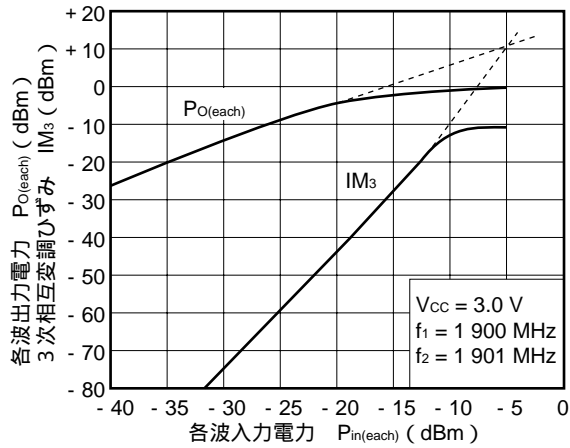
出力電力 vs. 入力電力



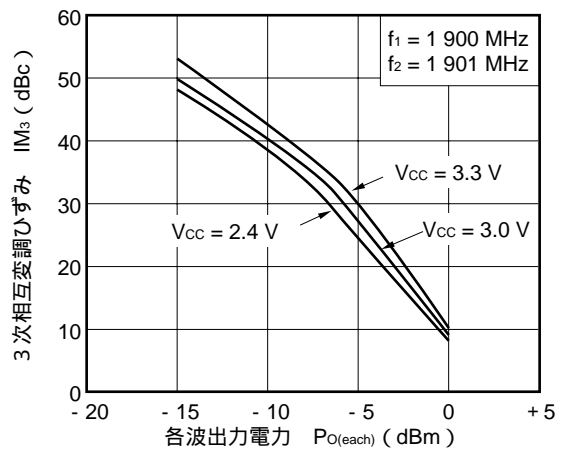
出力電力 vs. 入力電力



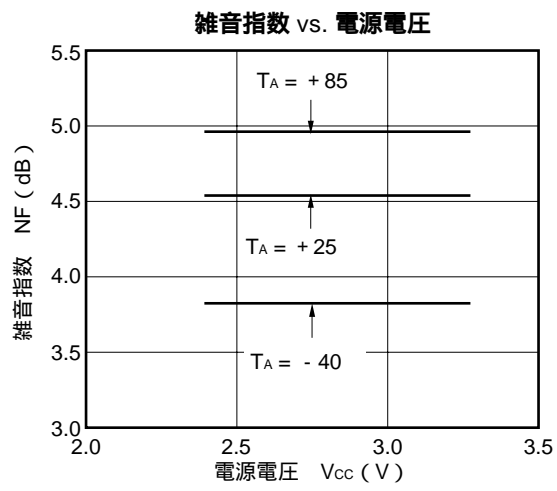
各波出力電力, 3次相互変調ひずみ vs. 各波入力電力



3次相互変調ひずみ vs. 各波出力電力



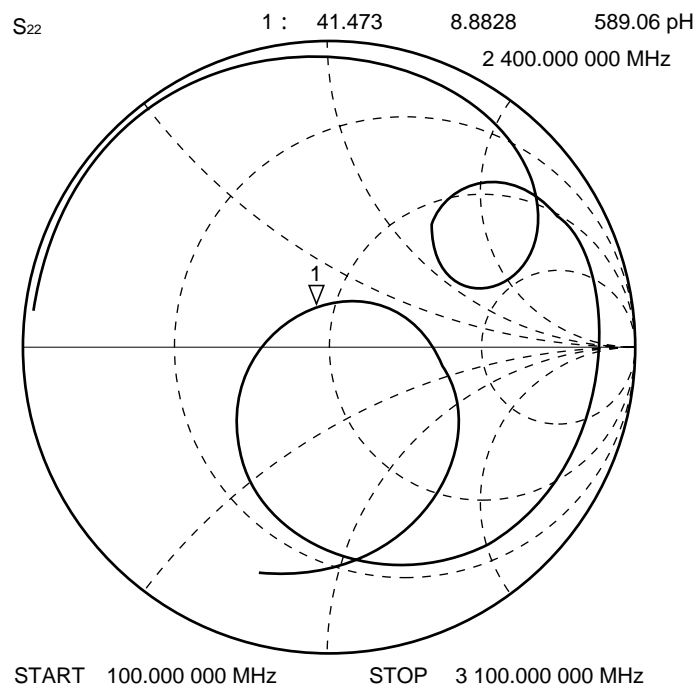
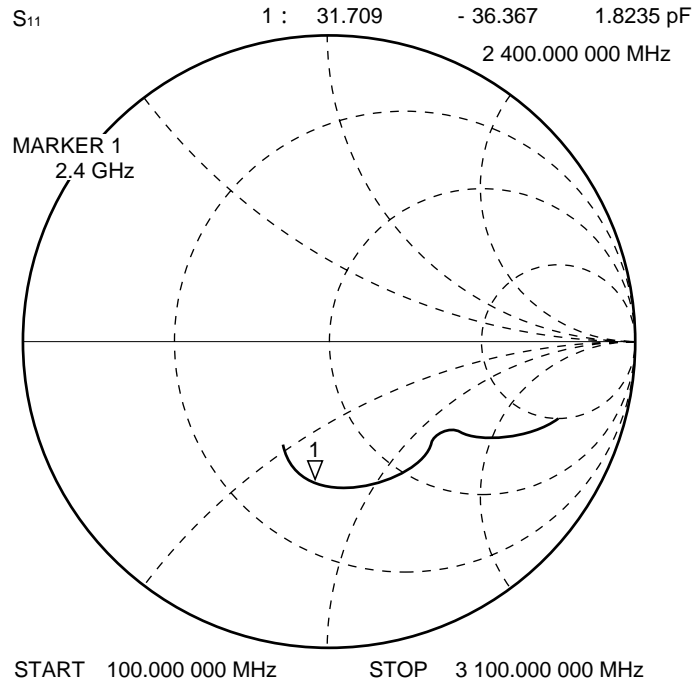
出力1.9 GHzマッチング時



出力2.4 GHzマッチング時

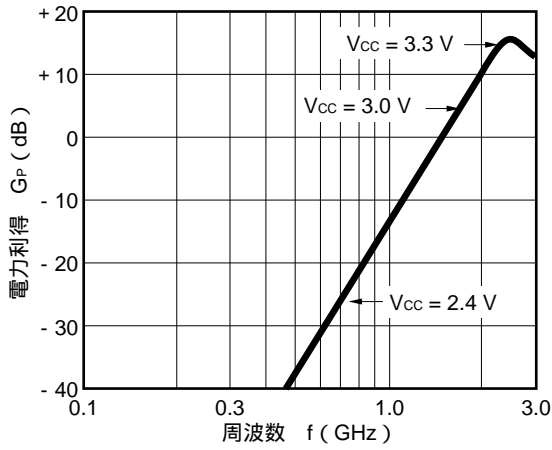
Sパラメータ (測定治具のコネクタ部にてモニタ)

$T_A = +25$, $V_{CC} = V_{out} = 3.0$ V

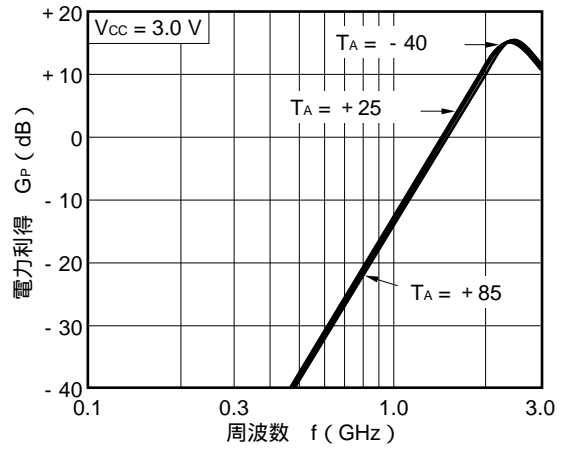


出力2.4 GHzマッチング時

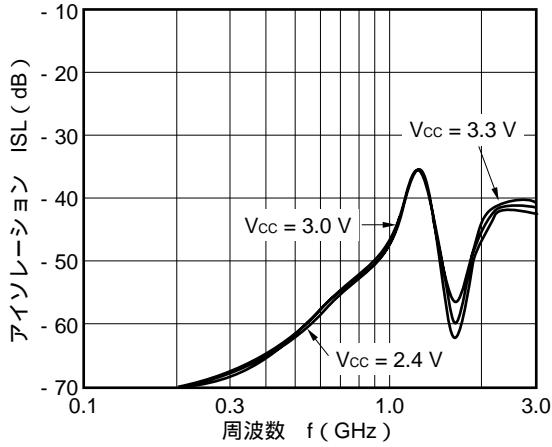
電力利得 vs. 周波数



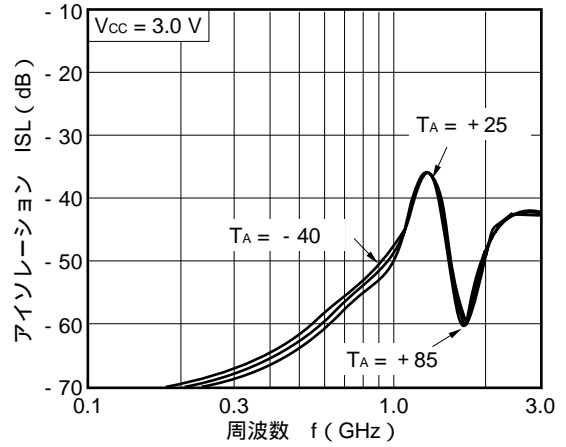
電力利得 vs. 周波数



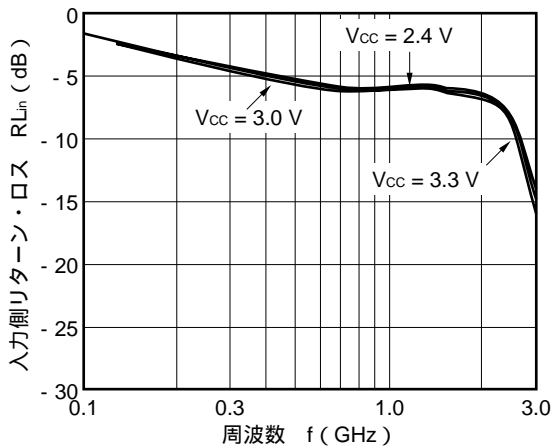
アイソレーション vs. 周波数



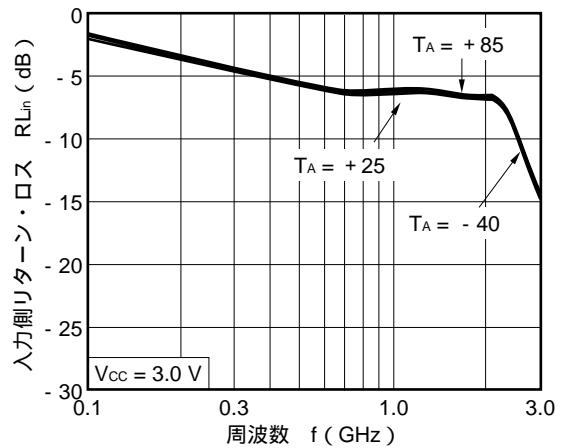
アイソレーション vs. 周波数



入力側リターン・ロス vs. 周波数

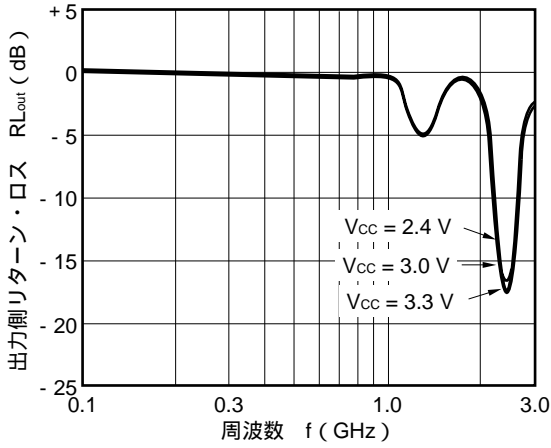


入力側リターン・ロス vs. 周波数

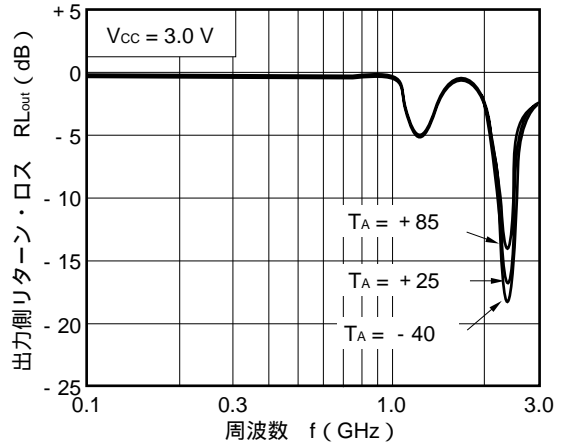


出力2.4 GHzマッチング時

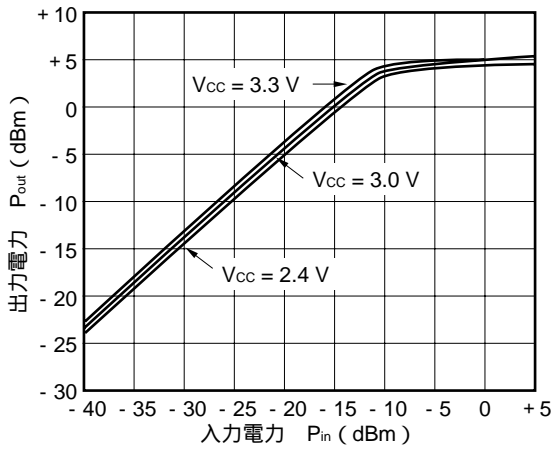
出力側リターン・ロス vs. 周波数



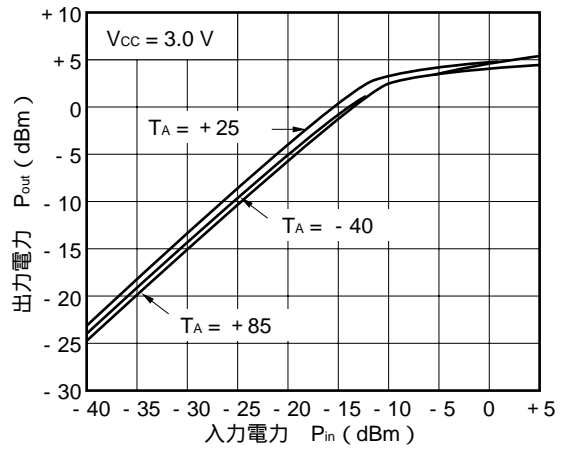
出力側リターン・ロス vs. 周波数



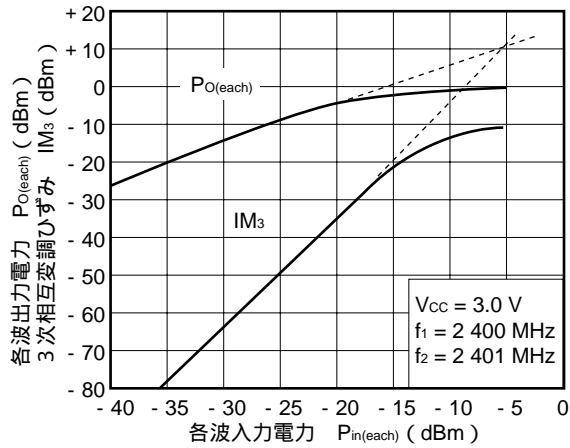
出力電力 vs. 入力電力



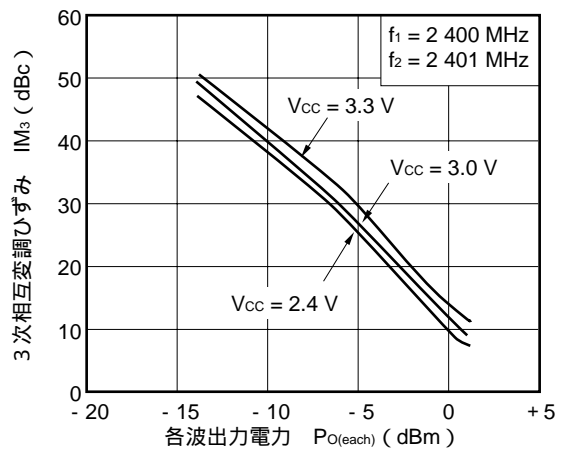
出力電力 vs. 入力電力



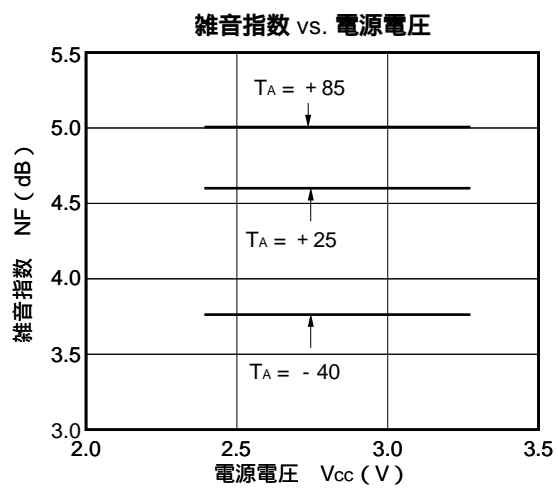
各波出力電力, 3次相互変調ひずみ vs. 各波入力電力



3次相互変調ひずみ vs. 各波出力電力



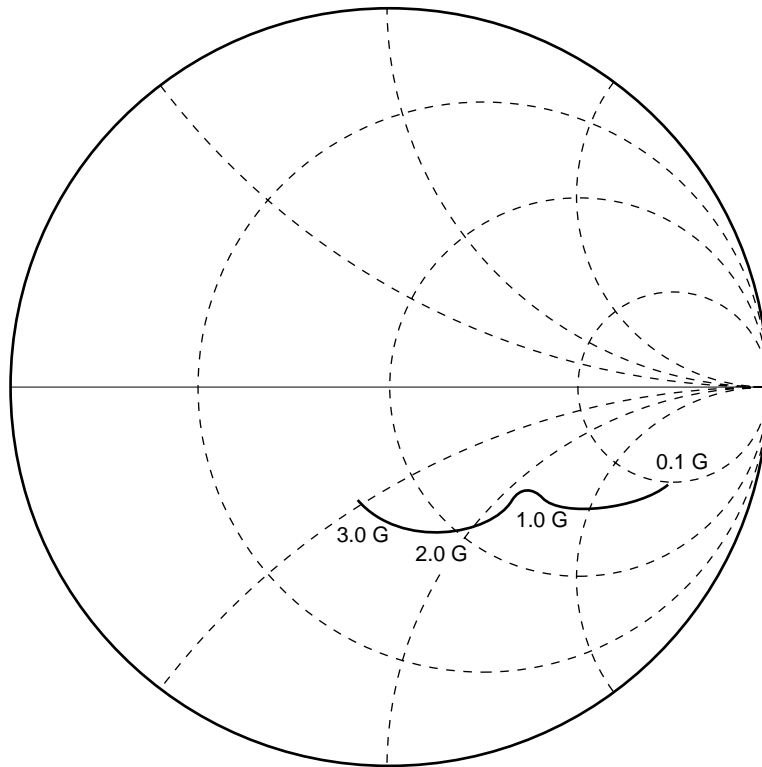
出力2.4 GHzマッチング時



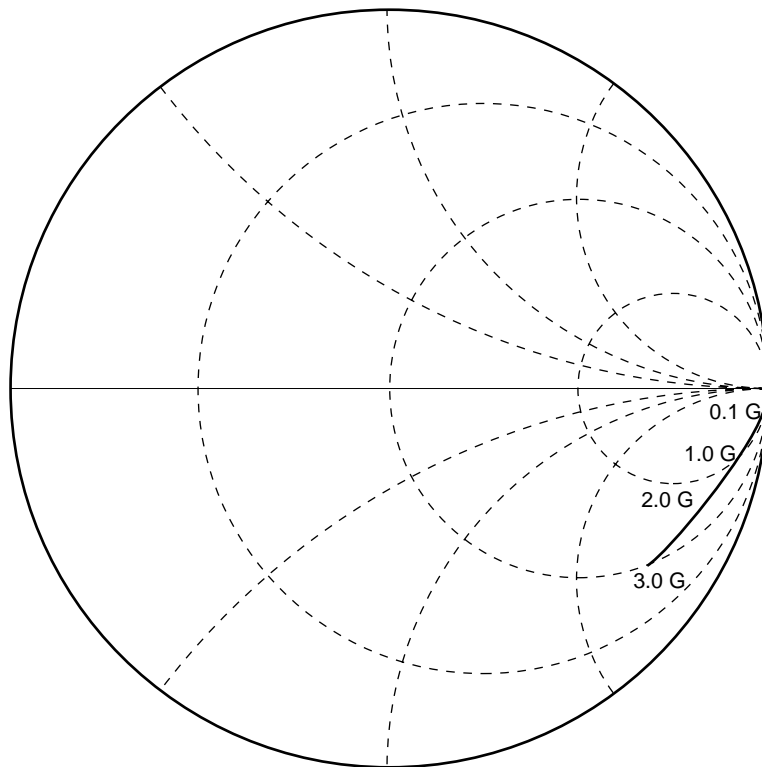
備考 グラフ中の値は参考値を示します。

Sパラメータ ($T_A = +25$, $V_{CC} = V_{out} = 3.0\text{ V}$)

S₁₁-周波数



S₂₂-周波数



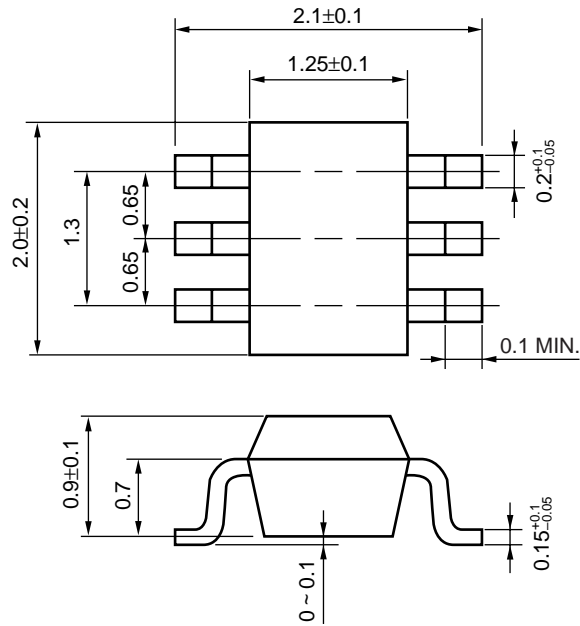
Sパラメータ参考値 (TA = +25)

VCC = Vout = 3.0 V, Icc = 4.0 mA

FREQUENCY MHz	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂	
	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.
100.0000	0.824	- 17.1	1.181	- 177.7	0.002	108.8	0.996	- 2.4
200.0000	0.692	- 25.9	1.181	- 172.4	0.003	64.7	0.986	- 4.0
300.0000	0.594	- 29.2	1.247	- 167.4	0.004	51.3	0.980	- 5.8
400.0000	0.533	- 30.7	1.370	- 164.1	0.005	55.8	0.965	- 7.5
500.0000	0.499	- 31.1	1.514	- 162.4	0.005	60.6	0.958	- 8.6
600.0000	0.474	- 32.0	1.677	- 162.9	0.006	46.6	0.950	- 10.1
700.0000	0.460	- 32.7	1.885	- 163.8	0.006	42.9	0.941	- 11.2
800.0000	0.450	- 34.0	2.050	- 166.3	0.006	45.9	0.935	- 12.4
900.0000	0.441	- 35.6	2.237	- 169.2	0.005	42.1	0.929	- 13.8
1000.0000	0.438	- 37.7	2.460	- 173.1	0.007	34.0	0.918	- 14.9
1100.0000	0.431	- 39.8	2.627	- 177.3	0.007	46.9	0.914	- 16.0
1200.0000	0.426	- 42.0	2.772	178.4	0.005	27.7	0.903	- 17.0
1300.0000	0.427	- 44.8	2.965	173.2	0.005	40.2	0.895	- 18.3
1400.0000	0.417	- 48.1	3.123	168.0	0.004	24.4	0.891	- 19.5
1500.0000	0.413	- 50.6	3.199	161.8	0.006	45.5	0.884	- 20.4
1600.0000	0.408	- 54.6	3.351	156.8	0.005	44.6	0.877	- 21.1
1700.0000	0.398	- 57.6	3.345	151.2	0.003	42.4	0.867	- 22.1
1800.0000	0.387	- 61.6	3.403	145.5	0.005	42.7	0.861	- 23.0
1900.0000	0.380	- 64.9	3.361	140.9	0.005	59.5	0.859	- 24.4
2000.0000	0.366	- 69.1	3.375	136.3	0.004	45.4	0.852	- 25.1
2100.0000	0.352	- 72.1	3.350	132.3	0.003	58.3	0.846	- 25.9
2200.0000	0.341	- 75.6	3.304	127.9	0.003	73.9	0.847	- 26.4
2300.0000	0.330	- 79.4	3.347	124.8	0.006	81.1	0.839	- 27.4
2400.0000	0.320	- 82.4	3.325	121.2	0.006	98.3	0.839	- 28.2
2500.0000	0.304	- 85.6	3.275	117.3	0.006	100.5	0.838	- 29.1
2600.0000	0.296	- 88.2	3.284	113.7	0.004	114.6	0.834	- 29.7
2700.0000	0.285	- 91.7	3.283	111.0	0.005	104.8	0.830	- 30.6
2800.0000	0.272	- 94.3	3.224	106.5	0.005	114.1	0.831	- 31.4
2900.0000	0.267	- 96.9	3.333	104.3	0.008	127.8	0.837	- 32.0
3000.0000	0.256	- 99.5	3.251	101.1	0.009	126.3	0.831	- 33.4
3100.0000	0.248	- 101.9	3.381	96.0	0.008	134.1	0.833	- 34.0

外形図

6ピン小型ミニモールド (単位 : mm)



使用上の注意事項

- (1) 本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。
- (2) グランド・パターンは極力広く取り、接地インピーダンスを小さくしてください（異常発振の防止のため）。
特にグランド端子はインピーダンス差が生じないようにパターンをつなげてください。
- (3) Vcc端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。
- (4) 出力端子とVcc端子間にインダクタ（L）を挿入してください。Lの値は出力の直列容量（C）と使用周波数に応じて調整してください。
- (5) 入力端子は信号源とDCカット・コンデンサでカップリングしてください。

半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：235 ，時間：30秒以内（210 以上），回数：3回 制限日数：なし ^注	IR35-00-3
VPS	パッケージ・ピーク温度：215 ，時間：40秒以内（200 以上），回数：3回 制限日数：なし ^注	VP15-00-3
ウェーブ・ソルダリング	半田槽温度：260 以下，時間：10秒以内，回数：1回 制限日数：なし ^注	WS60-00-1
端子部分加熱	端子部温度：300 以下，時間：3秒以内（デバイス一辺あたり） 制限日数：なし ^注	-

注 ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は25 ，65%RH以下。

注意 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱方式は除く）。

実装の方法および注意事項に関しましてはインフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」（C10535J）をご参照願います。

(メモ)

(メモ)

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

— お問い合わせ先 —

【技術的なお問い合わせ先】

NEC半導体テクニカルホットライン
 (電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電話 : 044-435-9494
 FAX : 044-435-9608
 E-mail : s-info@saed.tmg.nec.co.jp

【営業関係お問い合わせ先】

第一販売事業部	第二販売事業部	第三販売事業部
東京 (03)3798-6106, 6107, 6108	東京 (03)3798-6110, 6111, 6112	東京 (03)3798-6151, 6155, 6586, 1622, 1623, 6156
名古屋 (052)222-2375	立川 (042)526-5981, 6167	水戸 (029)226-1702
大阪 (06)6945-3178, 3200, 3208, 3212	松本 (0263)35-1662	広島 (082)242-5504
仙台 (022)267-8740	静岡 (054)254-4794	高崎 (027)326-1303
郡山 (024)923-5591	金沢 (076)232-7303	鳥取 (0857)27-5313
千葉 (043)238-8116	松山 (089)945-4149	太田 (0276)46-4014
		名古屋 (052)222-2170, 2190
		福岡 (092)261-2806

【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特约店へお申しつけください。

【インターネット電子デバイス・ニュース】

NECエレクトロニクスデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス) <http://www.ic.nec.co.jp/>